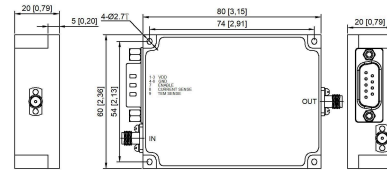


2000–3000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 50 W

GaN 증폭기는 2000–3000 MHz에서 전형 포화 출력 50 W와 이득 47 dB를 제공합니다. 전형 평탄도는 ± 1 dB이며 고조파 전형값 -12 dBc의 측정 조건은 30 W 출력입니다.



전기 사양 · Pin=0dBm; +28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	2000	-	3000	MHz
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	-	50	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	± 1	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-	-10	dB
30 W 조건의 고조파	H	-	-12	-	dBc
스퓨리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-50	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	32	VDC
전력 부가 효율	Eff	-	30	-	%

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm 최대
부하 VSWR	6:1; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C $\pm$ 5 °C $\rightarrow$ 정지 (최대)

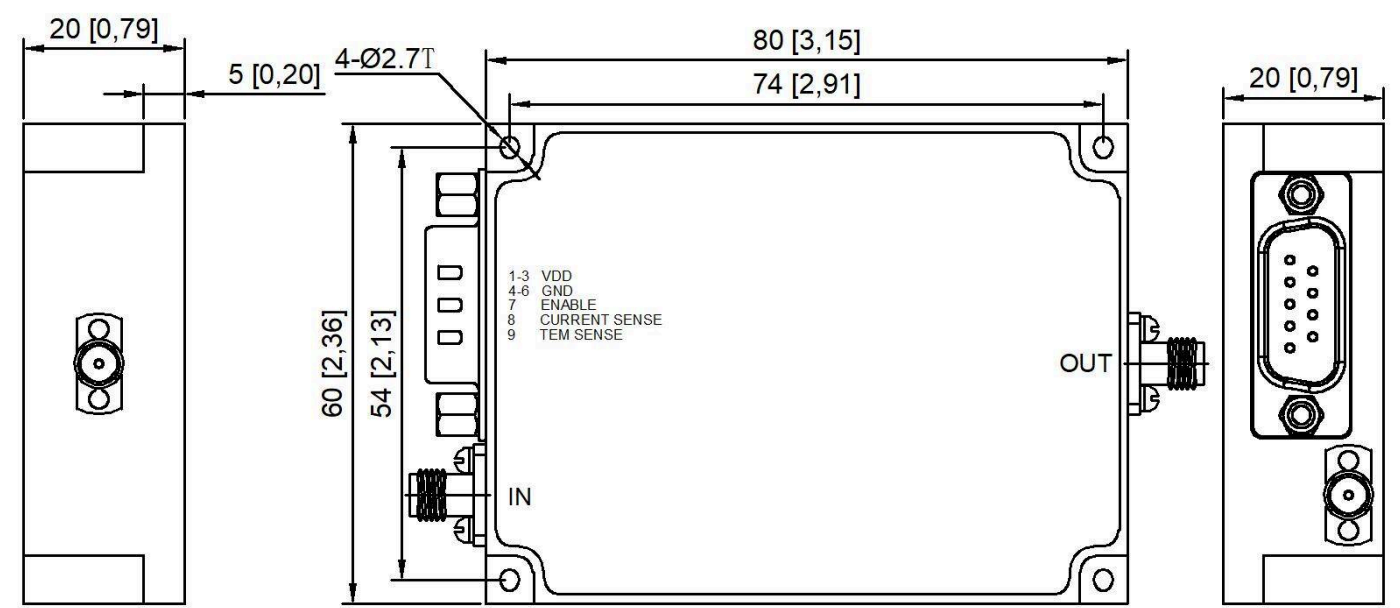
환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	55	°C	-
보관 온도	-40	-	85	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양 · 원자료 표는 핀 8을 온도 감지, 핀 9를 전류 감지로 지정하지만 원래 도면은 두 기능을 반대로 표시합니다. 배선 전에 핀 8/9의 기능을 확인해야 합니다.

항목	값	단위
외형 치수	80 × 60 × 20 [3.15 × 2.36 × 0.78] mm [in]	mm [in]
중량	0.5 [1.1] kg [lb]	kg [lb]
RF 입력 커넥터	J1 : SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	J2 : SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	J3 : DB9, 수	-

기구 외형도



모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
1-3	1-3 — 전원 양극	28VDC~32VDC
4-6	4-6 — 접지	접지
7	7 — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.